

УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ И ФОТОПРОВОДИМОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

Г. Т. ШЕЧКОВ, Ю. А. ЗАХАРОВ

(Представлена научным семинаром кафедры радиационной химии)

В работах [1—6] изложены результаты исследования электропроводности и фотопроводимости азидов свинца и серебра, являющихся инициирующими взрывчатыми веществами, а также предлагаются механизмы термического разложения этих соединений. В некоторых случаях [1] наблюдаются расхождения величины и даже вида температурной зависимости электропроводности AgN_3 , полученных на различных установках, что связано, вероятно, с различными условиями проведения эксперимента.

Это, в свою очередь, затрудняет корреляцию результатов электрофизических измерений азидов с данными по термическому разложению ввиду различных условий проведения эксперимента. Нами сконструирована простая установка, позволяющая одновременно измерять электропроводность и фотопроводимость высокоомных материалов.

Кроме того, установка позволяет измерять эти же характеристики в процессе термического разложения исследуемого объекта.

Описание установки

Схема установки представлена на рис. 1 и состоит из измерительной ячейки (1), источника света (6) с монохроматором и регистрирующего прибора В2-5. Измерительная ячейка (1) стеклянная, разъем-

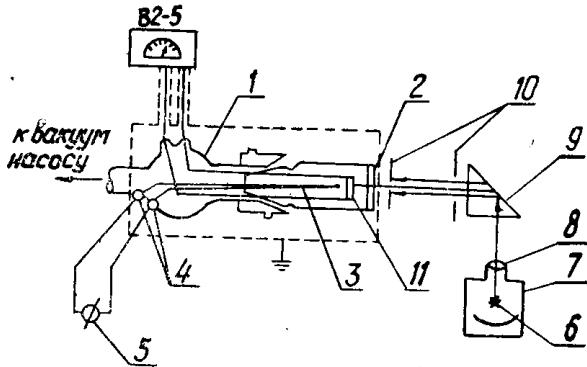


Рис. 1. Схема установки для измерения темновой
и фотопроводимости.

ная, вакуумная, подробно описана в [8]. Использование в ячейке кварцевого окна (2) для освещения образца позволяет измерять фототоки в широком спектральном диапазоне ($220 + 1100 \text{ мкм}$).

Для устранения погрешностей в измерении температуры, при использовании компенсационных проводов, термопары (3) выводится из ячейки через вакуумно-плотные выводы (4), выполненные на основе эпоксидной смолы ЭД-5, и присоединяется к показывающему прибору ПП-Ш (5). Источником света в установке служит лампа сверхвысокого давления типа ДРШ-1000 (6), смонтированная в металлическом корпусе (7). Свет от лампы фокусируется кварцевой линзой (8) на призме (9) спектрофотометра СФ-4 и затем через микрометрические щели (10) попадает на образец (11).

Компенсационная схема измерения фототока представлена на рис. 2. В качестве регистрирующего прибора (1) нами использовался

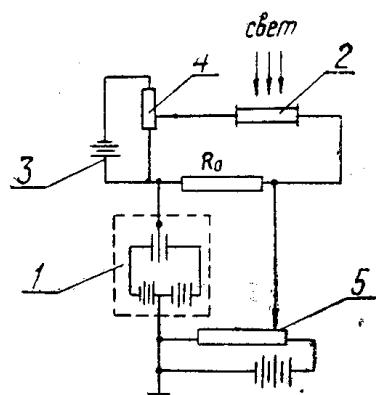


Рис. 2. Компенсационная схема изменения фототока

отечественный милливольтметр-электрометр ламповый В2-5. Напряжение на образец (2) подавали с батареи гальванических элементов БАС-80- \times -1 (3) и регулировали потенциометром ВЗР на 1.5 Мом (4).

Сопротивление нагрузки R_0 представляет набор образцовых сопротивлений ($10^{11}, 10^{10}, 10^9, 10^8, 10^7, 10^6 \text{ ом}$) с переключателем от тераометра типа Ф-57 и позволяет измерять сопротивление от 10^6 до 10^{15} ом . При измерении фотопроводимости компенсация сигнала темновой проводимости, поступающего на показывающий прибор В2-5 (1), производилась с помощью потенциометра ПП-Ш (5).

Установка имеет следующие параметры:

1. Пределы измерения сопротивлений $R 10^6 \div 10^{15} \text{ ом.}$;
2. Напряжение, подаваемое на образец $I = 1 \div 400 \text{ в.}$
3. Рабочее давление в системе $10^{-5} \text{ мм рт. ст.}$
4. Диапазон рабочих температур $t = 20 + 250^\circ \text{ С.}$
5. Ошибка измерений не более 10%.

На описанной выше установке были проведены измерения темновой и фотопроводимости азида свинца и темновой проводимости азида серебра в вакууме. На образец подавали напряжение 95 в., которое зарядомо меньше пробойного (250 в. см. обзор [6]).

Полученные результаты сопоставлены с литературными и сведениями в табл. 1.

Таблица 1

Удельное сопротивление, фототок, энергия активации PbN_6 и AgN_3

Формула соединения	$R, \text{ом}^{-1}\text{сек}^{-1}$	$E_{\text{акт}_T},$ ккал/моль	Фототок, (ампер)	$E_{\text{акт}\phi},$ ккал/моль	Литература
PbN_6	$1,5 \times 10^{13}$	—	—	—	(4)
PbN_6	—	—	4×10^{-12}	8,2	(5)
PbN_6	$0,99 + 1,06 \times 10^{13}$	32	2×10^{-14}	9,7	Наши результаты
AgN_3	3×10^8	24,8	—	—	(6)
AgN_3	$3,5 \times 10^8$	25,0	—	—	Наши результаты

где R — темновое сопротивление образцов,

$E_{\text{акт}_T}$ и $E_{\text{акт}\phi}$ — соответственно энергии активации темновой и фотопроводимости. Различие результатов по величине фотопроводимости PbN_6 может быть связано с различной напряженностью поля у нас (65 в/см) и у Дидмана и Левиса [5] (600 в/см), когда становится возможной инжекция носителей из электродов [7], а также различием в интенсивностях фотоактивного света.

ЛИТЕРАТУРА

1. D. A. Young Brit. J. Appl. Phys., 15, 499, 1964.
2. A. C. McLaren, G. T. Ringers, Proc. Roy. Soc., A240, 484, 1967.
3. B. E. Bartleff, F. S. Tompkins, F.R.S. D. A. Young. Proc. Roy. Soc., A245, 206, 1958.
4. B. L. Evans, A. D. Yobbe A250, 346, 15959.
5. A. J. Dedman, T. J. Lewis, Trans. Farad. Soc., 62, № 520, (часть 4), 1966.
5. A. J. Dedman, G. J. Lewis, Trans. Farad. Soc., 62, № 520, (часть 4) 1966.
6. B. L. Evans, A. D. Yobbe, P. Gray. Chem. Rev. 59, 515, 1959.
7. С. М. Рыбкин. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. М., 1963.
8. Ю. А. Захаров, Г. Г. Савельев, Г. Т. Шечков. Ж.Ф.Х (в печати).

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
4	Табл. 4	Расщепление	Расщепление, гаусс
8	Рис. 2	1000 ,A	10000 ,A ⁰
19	I-ая снизу	В. М. Лихин ДАН СССР	В. М. Лыхин ДАН СССР
22	24 сверху	O = □ + 2e + 1/20 ₂	O = □ + e + 1/20 ₂
23	13 сверху	За счет электронов	За счет захвата электрона в
	16 сверху	Кристаллов постоянных	кристаллов постоянным
28	7 снизу	A → A ⁰ + e	A ← A ⁰ + e
36	12 снизу	Zoumeine	Roumeine
40	3 сверху	выходе	входе
44	5 снизу	(II)	(I)
47	3 сверху	и окружающее	в окружающее
51	Табл. I	NH ³⁺	NH ₃ ⁺
51	Табл. I	HCl ₃₇ ⁺	HCl ³⁷ ⁺
54	Рис. 2	t (сек)	1gt (сек)
64	5 сверху	кристаллах позволяет получить с контролируемой величиной поверхности	кристаллах с контролируемой величиной поверхности позволяет получить
69	8 сверху и 13 снизу	ПП-Ш	ПП-III
70	Табл. I	0,99 + 1,06 · 10 ¹³	0,99 + 1,06 · 10 ¹³
71	3 и 6 снизу авторы	А. Д. Уоббе	А. Д. Уоффе
71	7 снизу	Д. А. Захаров	Ю. А. Захаров
74	подпись под рис. 4	0,5 %	0,05 %
	10 снизу	lg δ	lg σ _γ
	подпись под рис. 1 и 2	N ₃ → N ₃ ⁰ + 1	N ₃ → N ₃ ⁰ + e
77	5 и 6 сверху	HO	H ₀
79	17 снизу	ClO	ClO ₃ ⁻
81	8 сверху	Cl ₄ → Cl ₄ , l, [ClO ₄ ⁻]*	ClO ₄ → ClO ₄ , e, [ClO ₄ ⁻]*
88	2 снизу	% 116δ	№ 1168
91	11 снизу	NH ₃	¹⁵ NH ₃
III.	1 снизу	I ₁₈	I ₁₈
126	7 сверху	₁₄ N ₁₅ N ⁺ , ₁₂ C ₁₆ O ⁺	₁₂ C ₁₆ O ⁺ , ₁₄ N ₁₅ N ⁺
128	1 снизу	Каделаци	Каденаци
132	11 сверху	Kj	KI
146	5 снизу	G = g + j	G = g + V _k
		V	спектроскопия